

Multi Function Tester TC1

Eigenschaften:

Es kann weithin verwendet werden, um zu erkennen **NPN und PNP-Transistor, Kondensator, Widerstand, Diode, Triode, N-Kanal und P-Kanal MOSFET, IGBT, JFET, Triac und Batterie** Etc.

Es kann auch verwendet werden, um zu erkennen **Infrarotwellenformen**.

Es kann auch erkennen **Zenerdiode** Und hat die Funktion von **Selbstkalibrierung**.

Nach der Erkennung richten Sie die Infrarot-Fernbedienung mit der "IR" -Licht aus, und drücken Sie dann die Taste in der Fernbedienung, wenn der Detektor es erfolgreich dekodiert, zeigt er den Datencode und die Infrarotwellenform an.

Einknopfbedienung, Automatisch erkennen und abschalten, und Sie können die Multifunktionstaste drücken, um den Detektor zu schließen.

Setzen Sie die Stifte der Komponente in den entsprechenden Bereich, dann wählen Sie den kleinen Griff und der Detektor wird es automatisch testen, schließlich werden die Ergebnisse auf dem Hintergrundbeleuchtung TFT-Bildschirm deutlich angezeigt.

Nicht wie die übliche Schwarz-Weiß-Anzeige, **Dieser Detektor zeigt Ergebnisse in Farbe**.

Technische Daten:

Anzeige: 1.8**Zoll-TFT-Bildschirm**

Diodenbereich: <**4,5V**

Zener-Diode: Transistor-Erkennungsbereich: **0,01-4,5 V**

Zener Diode Erkennungsbereich: **0.01-30V**

Triac Reichweite: **IGT <6mA**

Kapazität: **25PF-100mF**

Widerstand: **0,01-50MΩ**

Induktivität: **0.01MH-20H**

Batterie: 0.1-4.5V

Power Modus: Wiederaufladbare Lithium Batterie (**INBEGRIFFEN**)

Einzelteil-Größe: 8.8 x 8 x 2.8cm / 3.47 x 3.15 x 1.10in

Einzelteil-Gewicht: 111.5g / 3.94oz

Paket Größe: 14.5 x 12 x 2.7cm / 5.71 x 4.73 x 1.06in

Paketgewicht: 114g / 4.02oz

Operating Instructions

1. Key operational definitions

Multi-function key has two actions:

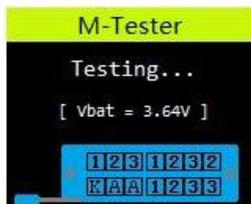
Short press: Press the key and not less than 10 ms, release key within 1.5 seconds

Long press: Press the key more than 1.5 seconds

2. Power on

In the power off state, short press the multifunction key, the tester is turned on and automatically measured.

Power on & measurement interface



1.3 Detect transistor

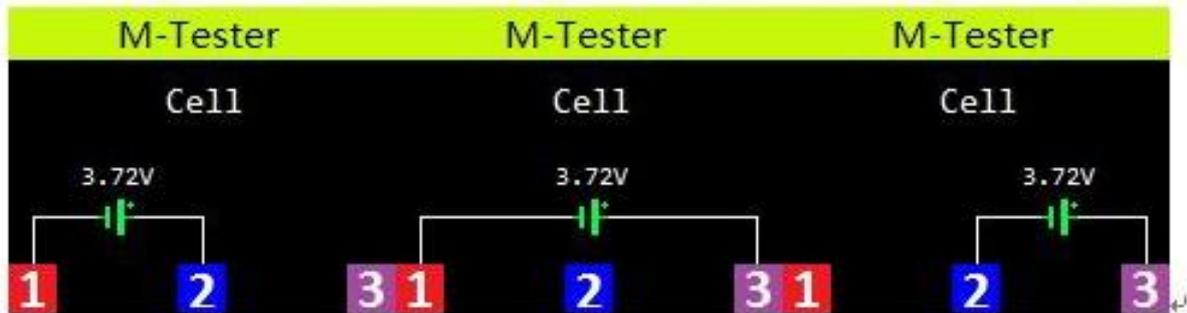
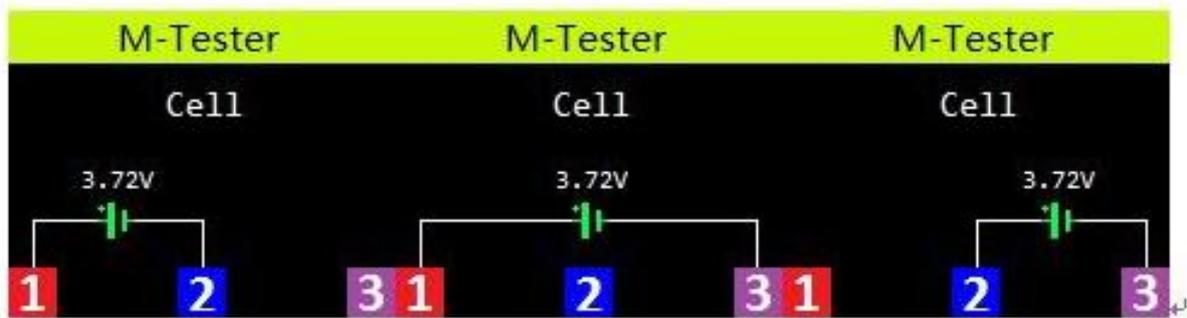
In the power off state or the test is completed, put the test element into the transistor test area of test seat, and press the locking handle, short press the multifunction key, the tester automatically measure, graphical display of measurement results when testing is complete.

Warning: Always be sure to DISCHARGE capacitors before connecting them to the tester! The tester may be damaged before you have switched it on!

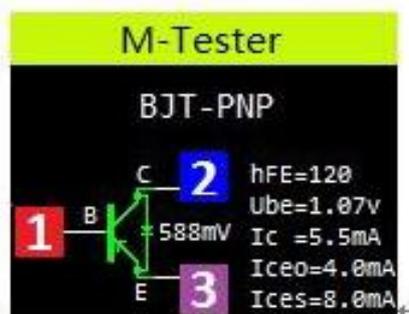
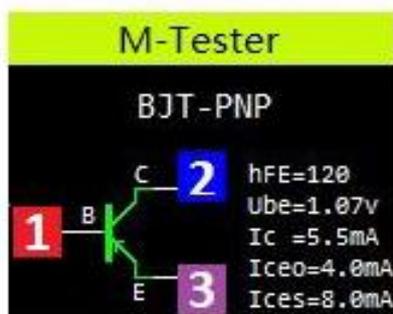
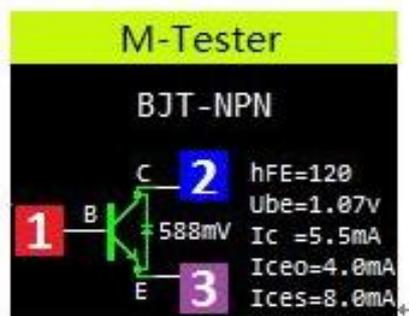
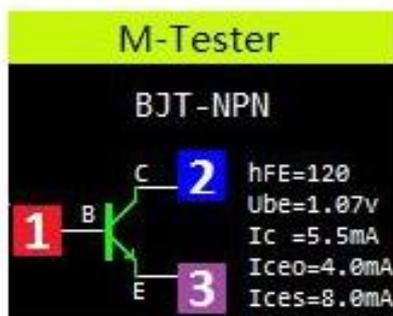
Warning: We do not recommend using the tester to measure the battery! The battery voltage must be less than 4.5V, otherwise the tester may be damaged!

Component placement

Test seat are divided into transistors and zener diode test area



BJT(Bipolar Junction Transistor)↵



The main performance parameters are as follows:

Component	Range	Parameter Description
BJT	-	hFE(DC Current Gain), Ube(Base-Emitter Voltage), Ic(Collector Current), Iceo(Collector Cut-off Current (IB=0)), Ices(Collector short Current), Uf(Forward Voltage of protecting diode) ③
Diode	Forward Voltage <4.50V	Forward Voltage, Diode Capacitance, Ir(Reverse Current) ②
Double Diodes		Forward Voltage
Zener Diode	0.01-4.50V (Transistor test area)	Forward Voltage, Reverse Voltage
	0.01-30V (Zener Diode test area)	Reverse Voltage
MOSFET	JFET	Cg(Gate Capacitance), Id(Drain Current) at Vgs(Gate to Source Threshold Voltag), Uf(Forward Voltage of protecting diode) ④
	IGBT	Id(Drain Current) at Vgs(Gate to Source Threshold Voltage), Uf(Forward Voltage of protecting diode) ④
	MOSFET	Vt(Gate to Source Threshold Voltag), Cg(Gate Capacitance), Rds(Drain to Source On Resistance), Uf(Forward Voltage of protecting diode) ④
Thyristor	Igt(Gate trigger current)<6mA	Gate trigger voltage
Triac		
Capacitor	25pF-100mF	Capacitance, ESR(Equivalent Series Resistance), Vloss ①
Resistor	0.01-50MΩ	Resistance
Inductor	0.01mH-20H	Inductance, DC Resistance ⑤
Battery	0.1-4.5V	Voltage, Battery Polarity